

平成 27 年 9 月 4 日

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 91 回委員総会・第 95 回研究会 開催案内
(薄膜 第 131 委員会と合同研究会)

日時：平成 27 年 10 月 2 日 (金)

委員総会：12:00 - 13:00

研究会：13:00 - 17:30

意見交換会：17:30 - 19:00

場所： 京都リサーチパーク (KRP) 4 号館 (西地区)

委員総会／研究会：2 階 ルーム 1、意見交換会：地下 1 階 バンケットホール

(JR 嵯峨野線(山陰線)丹波口駅 徒歩 5 分)

〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町 90～94

TEL: 075-322-7888, <https://www.krp.co.jp/>

委員会

議 題：

- (1) 前回第 90 回委員総会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第 96 回研究会以降の研究会について
- (4) 平成 26 年度収支決算監査報告
- (5) 名古屋大学赤崎記念研究センターシンポジウムの協賛依頼について
- (6) 第 18 回結晶成長国際会議 (ICCGE-18) の協賛依頼について
- (7) ISPlasma2016/IC PLANTS2016 の協賛依頼について
- (8) その他

報告事項：

- (1) 開催報告：2015 日独西ワークショップ
- (2) 開催案内：第 9 回ワイドギャップ半導体セミナー(10 月 22-24 日)について
- (3) 開催案内：1st International Workshop on Gallium Oxide and Related Materials (IWGO2015)
- (4) 開催案内：6th Int. Symp. Growth of III-Nitrides (ISGN-6)
- (5) その他

研究会

主 題： 「エネルギーマネージメントデバイス」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」(13:00 - 13:10)

1. 「シリコンパワーデバイスの限界への挑戦」(13:10 - 13:50)

中川 明夫 (中川コンサルタント事務所)

2. 「ロームにおける SiC パワーデバイス開発」(13:50 - 14:30)

中村 孝 (ローム)

3. 「SiC 基板の評価技術とデバイス特性」(14:30 - 15:10)

北島 真 (東洋炭素)

休憩 (15:10 - 15:30)

4. 「Ge ドープ再成長層によるノーマリーオフ型 NiO ゲート GaNHFET の超低オン抵抗化」

(15:30 - 16:10)

鈴木 朝実良 (パナソニック)

5. 「GaN パワーデバイス開発と量産化の展開」(16:10 - 16:50)

吉川 俊英 (トランスフォーム・ジャパン)

6. 「Ga₂O₃ パワーデバイスの展望と課題」(16:50 - 17:30)

東脇 正高 (情報通信研究機構)

<追記>

1. 10月2日の委員総会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
3. 意見交換会に出席される方は、当日 2,000 円を申し受けますので、よろしく願いいたします。
4. 準備の都合上、委員総会・研究会の出欠回答を 9月24日(木)までに日本学術振興会研究事業課 須賀 様 (jigyouka06@jsps.go.jp) 宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。